



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 19 卷 第 6 期 1998 年 6 月

目 次

InAs 自组织生长量子点超晶格的电学性质 陈 枫 封松林 杨锡震 王志明 赵 谦 温亮生 (401)

硅的位错核心结构无悬挂键 咎育德 (406)

InAs 薄膜 Hall 器件的材料生长与特性研究 王红梅 曾一平 周宏伟 董建荣 潘 栋 潘 量 孔梅影 (413)

$\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{InP}$ 应变量子阱中激子跃迁能量随 In 组分的变化 王晓亮 孙殿照 孔梅影 侯 洵 曾一平 (417)

SiC 纳米粉的光致发光研究 杨修春 韩高荣 张孝彬 丁子上 (423)

激光 CVD 制备 SnO_2 薄膜的结构及其反应机理研究 戴国瑞 姜喜兰 南 金 张玉书 (427)

提高 Spindt 型场发射冷阴极阵列发射均匀性的方法 张友渝 江泽流 宗婉华 王文喜 张大立 王民娟 (431)

Fabrication and Characterization of High-Voltage Ultra-Fast GaAs Photoconductive Switch Shi Wei(施 卫), Liang Zhenxian(梁振宪), Xu Chuanxiang(徐传骧) (437)

MCT 最大可关断电流的解析分析 周宝霞 陈治明 (442)

掺施主杂质半导体中 LO 声子的反对称光电响应的 Monte Carlo 模拟 陈张海 陈忠辉 刘普霖 石晓红 史国良 胡灿明 沈学础 (447)

VLSI 金属化布线电徙动力学温度相关性研究 李志国 郭伟玲 朱 红 吉 元 程尧海 孙英华 张万荣 (452)

一种简便有效的多孔硅后处理新方法 熊祖洪 刘小兵 廖良生 袁 帅 何 钧 周 翔 曹先安 丁训民 侯晓远 (458)

8-羟基喹啉铝/镁结接触特性研究 张立功 刘学彦 蒋大鹏 吕安德 元金山 (463)

纳米级 PtSi/Si(111)膜成形工艺与连续性研究 王培林 盛文斌 杨晶琦 徐达鸣 (468)

退火处理对氧化锌透明导电膜的结构及电学特性的影响 马 瑾 计 峰 李淑英 马洪磊 (472)

研究快报

不同温度下快速热退火对 SiGe 量子阱光致发光谱的影响 司俊杰 杨沁清 王红杰 雷红兵 滕 达 王启明 刘学锋 李建民 (477)